

Silicon Diode

BA133

1000V / 300mA

DATASHEET

OEM – Siemens

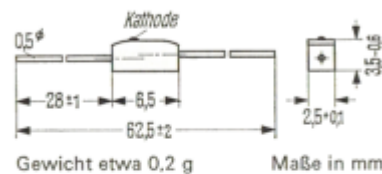
Source: Siemens Databook 1970/71

BA 133

Siliziumdiode in Kunststoffgehäuse für Blitzlichtgeräte

Die Siliziumdiode BA 133 mit Kunststoffumhüllung und axial angeordneten Anschlußdrähten eignet sich besonders für die Verwendung in elektronischen Blitzlichtgeräten zur Gleichrichtung von Wechselspannungen. Infolge der kleinen Gehäuseabmessungen kann diese Diode bei kompaktem Schaltungsaufbau und in gedruckten Schaltungen verwendet werden. Die Kathode ist durch einen orangefarbenen Punkt gekennzeichnet.

Typ	Bestellnummer
BA 133	Q 60201 – X 133



Grenzdaten ($T_U = 25^\circ\text{C}$)

Sperrspannung	U_R	1000	V
Spitzensperrspannung	U_{RM}	1000	V
Durchlaßstrom	I_F	300	mA
Spitzenstrom ($t = 1\ \mu\text{s}; r = 0$)	I_{FM}	30	A
Sperrschichttemperatur	T_j	125	$^\circ\text{C}$
Lagertemperatur	T_s	-30 bis +125	$^\circ\text{C}$

Wärmewiderstand Sperrschicht – Luft (Belastbarkeit nach Diagramm des Spitzenstromes)	R_{thJU}	200	grd/W
---	------------	-----	-------

Kenndaten ($T_U = 25^\circ\text{C}$)

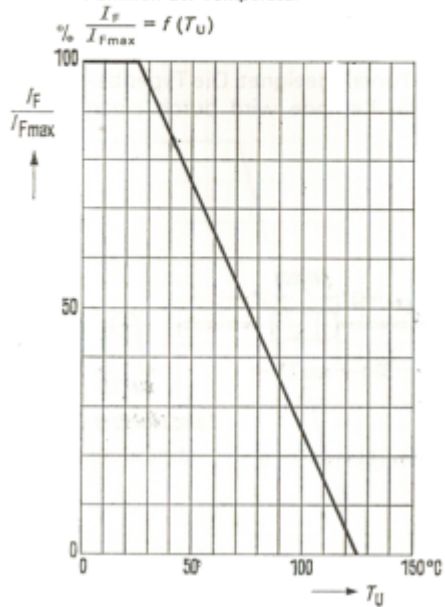
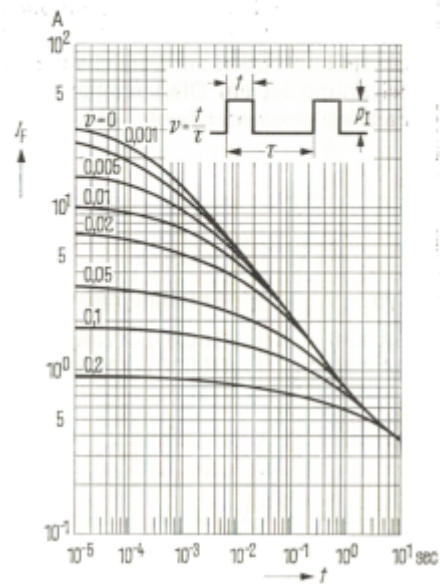
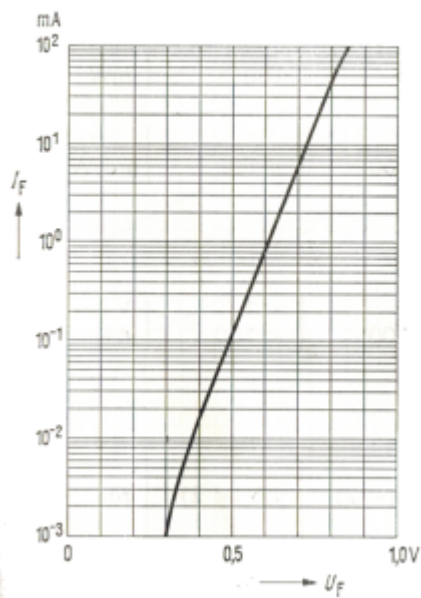
Durchlaßspannung ($I_F = 200\ \text{mA}$)	U_F	< 1,1	V
Durchlaßspannung ($I_F = 1,5\ \text{A}$)	U_F	< 1,6	V
Sperrstrom ($U_R = 1000\ \text{V}$)	I_R	0,05 (<1)	μA
Sperrstrom ($U_R = 1000\ \text{V}; T_U = 125^\circ\text{C}$)	I_R	< 50	μA
Kapazität ($U_R = 0\ \text{V}$)	C_o	10	pF

Anwendungshinweise:

Beim Einsatz der BA 133 als Netzgleichrichter (Eingangsspannung 220 V, 50 Hz) wird die Verwendung eines Schutzwiderstandes von minimal 50 Ω in Serie zur Diode empfohlen. Es kann ein Ladekondensator von maximal 50 μF bei einem Laststrom von 100 mA vorgesehen werden.

BA 133

Zulässiger Durchlaßstrom als Funktion der Temperatur

Zulässiger Impulsstrom
 $I_{FM} = f(t)$; $v =$ ParameterDurchlaßkennlinie $I_F = f(U_F)$
 $T_U = 25^\circ\text{C}$ Sperrkennlinie $I_R = f(U_R)$
 $T_U = 25^\circ\text{C}$ 